

证书号第8807578号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种在单晶硅或多晶硅上制备碳化硅复合涂层的化学气相沉积方法

专利权人：浙江六方半导体科技有限公司

地址：311800 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道大侣西路36号中节能环保产业园6号楼3楼

发明人：何少龙;丁柳宁

专利号：ZL 2024 1 0071607.2

授权公告号：CN 117845186 B

专利申请日：2024年01月18日

授权公告日：2026年03月27日

申请日时申请人：浙江六方半导体科技有限公司

申请日时发明人：何少龙;丁柳宁

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

